

97-0213

Rezumat:

Invenția se referă la fotoreceptori cu semiconductori, în special la receptori de radiație ultravioletă, și poate fi utilizată în sisteme optoelectronice de determinare a intensității și dozei de radiație ultravioletă emisă de Soare sau de alte surse.

În structura fotoreceptorului de radiație ultravioletă cu barieră de potențial superficială formată din semiconductori A^3B^5 cu banda energetică interzisă E_{g1} , soluțiile lor solide cu bandă energetică interzisă E_{g2} și SnO_2 sau ITO, în semiconductori A^3B^5 la o distanță de suprafață mai mică decât lungimea de absorbție a radiației vizibile este formată o heterojoncțiune izotipă între semiconductori A^3B^5 și soluțiile lor solide cu banda energetică interzisă $E_{g2} > E_{g1}$.

Rezultatul tehnic constă în confecționarea unui fotoreceptor sensibil numai la radiația ultravioletă.

Revendicări: 1

Figuri: 1